### 07

# Максимальное замедление и отрицательная дисперсия плазмонов вдоль металлического слоя

#### © М.В. Давидович

Саратовский государственный национальный исследовательский университет им. Н.Г. Чернышевского E-mail: DavidovichMV@info.sgu.ru

### Поступило в Редакцию 30 декабря 2016 г.

Получены максимальные замедления и их резонансные частоты для плазмонов в тонком металлическом слое. Рассмотрены аномальная отрицательная дисперсия и обратные плазмоны. Показано, что отрицательная дисперсия в структурах с диссипацией не всегда означает наличие обратного плазмона.

#### DOI: 10.21883/PJTF.2017.22.45261.16629

В тонких металлических слоях возможны аномальная отрицательная дисперсия и обратные плазмоны [1-3]. Движение энергии в слое из-за отрицательной действительной части  $\varepsilon' < 0$  диэлектрической проницаемости (ДП) противоположно ее движению в окружающем пространстве, а общий поток энергии может быть противоположен движению фазы. Смена знака у вектора Пойнтинга при  $\varepsilon' > 0$  также имеет место, если меняет знак постоянная распространения  $k'_{r}$ . Рассмотрим металлический слой  $|z| \leq t/2$  толщиной t в вакууме и электрические Е-плазмоны (ТМ-плазмоны) вдоль оси х с зависимостью  $E_x(x, z) = E_x(z) \exp(i\omega t - ik_x x)$ . Исследуем медленные поверхностные плазмоны (ПП). Компоненты  $E_z$  и  $H_y$  выражаются через  $E_x$ . Можно рассматривать и волны вдоль оси z, выражая все компоненты через Е<sub>z</sub>. Тогда вводим нормированные волновые сопротивления  $ho^e = E_x / \left( (\mu_0 / \varepsilon_0)^{1/2} H_y 
ight)$  в слое и вакууме, которые указывают на то, что выбор либо  $E_{ex}$ , либо  $H_v$  равноправен для описания ПП, поэтому можно классифицировать ПП по четности/нечетности компоненты  $H_y$  [1,4]. В вакууме  $\rho_0^e = \sqrt{1 - k_x^2/k_0^2}$ . В слое  $\rho^e = \sqrt{\varepsilon - k_x^2/k_0^2/\varepsilon}$ . Классификация ПП по четности/нечетности поперечных компонент [1,4] для

55



**Рис. 1.** Нормированная на плазменное волновое число дисперсия (a) и потери (b) электрического симметричного (ES), электрического антисимметричного (EAS) и магнитного симметричного (HS) ПП в слоях серебра. Числами около кривых указаны толщины пленок (в nm).

поперечно ограниченных структур менее общая, чем классификация по продольным компонентам, которая здесь использована. В случае диссипации  $k_x = k'_x - ik''_x$ , причем выбор k'' > 0 означает движение энергии в направлении x. Если при этом  $k'_x > 0$ , то плазмон прямой, а если  $k'_x < 0$  — обратный. Корень берем из условия  $k'_x > 0$ . Тогда обратный ПП классифицируется при введении бесконечно малых потерь как отрицательный знак у  $k''_r$ . ДП металла используем в форме Друде-Лоренца  $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_L - \omega_p^2/(\omega^2 - i\omega\omega_c)$ , где в  $\varepsilon_L$  учтены межзонные переходы и поляризация решетки. Поскольку плазмонный резонанс (ПР) имеет место при длинах волн 500-700 nm, считаем є действительной константой. Для серебряной пленки имеем  $\varepsilon_L = 22.5, \, \omega_p = 1.9 \cdot 10^{16} \, \mathrm{Hz}, \, \omega_c = 4.5 \cdot 10^{13} \, \mathrm{Hz}.$  Дисперсионное уравнение (ДУ) симметричного (четного) относительно  $E_x(z)$  *E*-ПП имеет вид  $\rho_0^e = -i\rho^e/\tan(k_z t/2)$  [3], что означает равенство импеданса волны в вакууме и входного импеданса при условии магнитной стенки при z = 0 [5]. Имеем ДУ

$$n = k_x/k_0 = \sqrt{\varepsilon^2 \tanh^2 \theta - \varepsilon} / \sqrt{\varepsilon^2 \tanh^2 \theta - 1}.$$
 (1)

Здесь  $\theta = t \sqrt{k_x^2 - k_0^2 \varepsilon}/2$ . В отсутствие потерь  $\varepsilon = \varepsilon_L - \omega_p^2/\omega^2$ ,  $\varepsilon_L > 0$ . Для плазмоники  $\omega < \omega_p/\sqrt{\varepsilon_L}$ ,  $\varepsilon < 0$ . Пусть толщина *t* мала. Обозначим  $\lambda = \omega_p^2/\omega^2$ ,  $x = n^2 - 1$ . Тогда  $\theta = \alpha \sqrt{1 + (n^2 - \varepsilon_L)/\lambda}$ ,  $\alpha = \omega_p/t/(2c)$ . Пусть  $\lambda > \varepsilon_L - n^2$ , n > 1, что имеет место при  $\lambda > \varepsilon_L - 1$ . Для  $\alpha \ll 1 \tanh^2 \theta \approx \theta^2 = \alpha^2 [1 - (\varepsilon_L - n^2)/\lambda]$ . Возводя (1) в квадрат, имеем

$$x = (\lambda - \varepsilon_L + 1) \left[ \alpha^2 (\lambda - \varepsilon_L)^2 [1 - (\varepsilon_L - 1 - x)/\lambda]^2 - 1 \right].$$
(2)

Максимальному замедлению  $n_m$  в (1) соответствует  $\lambda_m$ . Исследование кубического уравнения (2) показывает, что волны медленные при  $\lambda < \varepsilon_L - 1$ ; ветвь быстрых волн расположена при  $\varepsilon_L - 1 < \lambda < \varepsilon_L$ , в области  $\varepsilon_L < \lambda < \lambda_m$  находится запрещенная зона; в области  $\lambda_m < \lambda < \infty$  волны медленные. При диссипации  $k_x = k'_x - ik''_x$ , запрещенная зона исчезает: в ней имеет место распространение быстрых волн с большим затуханием (рис. 1,2). Нет резкого обрыва дисперсионной ветви в точке  $\lambda_m$ , а имеет место перегиб ветви с аномальной отрицательной дисперсией. Она означает отрицательную (по отношению к фазовой скорости  $v_p$ ) групповую скорость (ГС)  $v_g$ . В точке загиба  $v_g = \infty$ . ГС

в диссипативных средах и структурах может быть любой. Впервые на возможность  $v_g > c$  обратил внимание Эренфест в 1910 г. [5]. Теорема Леонтовича—Лайтхилла—Рытова, утверждающая эквивалентность ГС энергии в монохроматической волне, верна в абсолютно недиссипативных (гамильтоновых) структурах. В недиссипативных средах и структурах отрицательная ГС означает обратную волну. Далее показано, что в случае четного *E*-ПП волна всегда прямая. Это следует как из вычисления вектора Пойнтинга [1–3], так и из определения знака  $k''_x$ . Уравнение (2) может быть записано следующим образом:

$$x^{3} - 2x^{2}(\lambda - \varepsilon_{L} + 1) + x \left[ (\lambda - \varepsilon_{L} + 1)^{2} - \lambda^{2} / [\alpha(\lambda - \varepsilon_{L})]^{2} \right]$$
  
=  $\lambda^{2}(\lambda - \varepsilon_{L} + 1) / [\alpha(\lambda - \varepsilon_{L})]^{2}.$  (3)

Условие максимума (2)  $dx(\lambda)/d\lambda = 0$  эквивалентно условию  $v_g = d\omega/dk_x = \infty$ . В недиссипативных структурах  $v_g \leq c$ . Расчеты по формуле (1) показывают, что  $v_g < c$  ниже ПР и  $v_g \to 0$  при  $\lambda \to \lambda_m + 0$ , а при  $\lambda < \lambda_m$  решения нет. Преобразование (1) привело к дифференцируемой функции  $x(\lambda)$  в точке  $\lambda_m$ . К этому же приводят потери. Дифференцируя (3)  $\lambda$  и полагая  $dx/d\lambda = 0$ , имеем квадратное уравнение, из которого определяем x. В качестве нулевого приближения берем  $\lambda_m = 3\varepsilon_L/2 - 1 + \sqrt{(\varepsilon_L/2 - 1)^2 - 1}$  и уточняем на основе (2). Для серебра  $\lambda_0 = 31.7$ ,  $\lambda_1 = 54.2$ , и для t = 10 пт получаем  $n_m = 5.8$ . В качестве итерационной формулы удобно взять

$$\lambda_m = x_m [\alpha^2 (\lambda_m - \varepsilon_L)^3 - (x_m - (\lambda_m - \varepsilon_L + 1)) - \lambda_m \varepsilon_L] / [1 + (\lambda_m - \varepsilon_L) (\lambda_m / 2 - \varepsilon_L + 1)].$$
(4)

Тогда первая итерация дает  $\lambda_m = 54.2257$ ,  $x_m = 33.2061$ . Вторая итерация приводит к значениям  $x_m = 33.2064$ ,  $\lambda_m = 54.2251$ . В случае бесконечно толстой пленки  $\tanh \theta = 1$ , и уравнение (1) вырождается в ДУ Ценнека [5]  $n = n' - in'' = k_x/k_0 = \sqrt{\varepsilon/(\varepsilon + 1)}$ . Для нее ПР имеет место при  $\lambda_m = \varepsilon_L + 1$  на частоте  $\omega_s = \omega_P/\sqrt{\varepsilon_L + 1}$ . Диссипация приводит к ПР чуть ниже  $\omega_s$  и конечному максимальному замедлению (рис. 2). Считаем  $\varepsilon'' \ll 1$ ,  $\omega_c \ll \omega_s$ , что означает  $\omega_p^2 \omega_c/(\omega_s^3 + \omega_c^2 \omega_s) \ll 1$ . Для металлов  $\omega_c/\omega_p \leqslant 10^{-2}$ . Ищем максимум



Рис. 2. Нормированная на плазмонное волновое число дисперсия симметричного *E*-ПП для  $\varepsilon_L = 2$ ,  $\omega_p = 10^{16}$  при t = 2 (*I*-6), 10 nm (7) и  $t = \infty$  (8) для отношений  $\omega_c/\omega_p = 10^{-4}$  (*I*),  $10^{-2}$  (2,8),  $5 \cdot 10^{-1}$  (3), 1 (4),  $2 \cdot 10^{-1}$  (5,7),  $10^{-1}$  (6). Штриховая кривая 8 построена для  $\varepsilon_L = 2-0.01i$ 

 $n_m$ , вводя новую нормированную переменную  $\tilde{\lambda} = \omega_p^2/(\omega^2 + \omega_c^2)$  и малую расстройку относительно  $\tilde{\lambda} = \varepsilon_L + 1$ ; получим  $n_m \approx (1 - i)/\sqrt{2\varepsilon''}$ . При максимальном замедлении имеют место максимальные потери:  $n'_m \approx n''_m$ . Для серебра получаем  $n'_m \approx 3$ . При конечной толщине пишем  $\tanh^2 \theta \approx 1 - 4 \exp(-2\theta) = 1 - \gamma$ ,  $\theta = \theta' - i\theta''$ . Тогда имеем  $n_m \approx \sqrt{1 + 3/2\delta} - \gamma/2 + i\varepsilon''/\sqrt{\delta} - \gamma/2 + i\varepsilon''}$ . Рассмотрим вопрос об обратных ПП в тонких пленках, вводя бесконечно малые потери. В окрестности ПР можно записать  $n_m \approx \sqrt{z}$ . Для обратного ПП комплексное число z должно лежать либо в первом, либо во втором квадранте. Для *E*-ПП это приводит неравенству в виде отрицательного значения квадратного трехчлена. Оно не может быть выполнено из-за его



**Рис. 3.** Прямые (линии 1, 3, 5) и обратные (символ B, линии 2, 4, 6) плазмонполяритонные ветви для антисимметричного электрического (1-4) и симметричного магнитного (5, 6) плазмонов в слое 50 (1, 2), 100 (3, 4) и 10 nm (5, 6).

отрицательного детерминанта. Для антисимметричного *Е*-ПП обратный плазмон существует. В [1] это получено путем вычисления вектора Пойнтинга.

На рис. 1 приведены дисперсия и потери для четного и нечетного *E*-ПП в пленках серебра, полученные итерационным решением ДУ (1) с диссипацией. Там же приведены результаты для четного *H*-ПП. На рис. 2 приведены результаты для четного *E*-ПП и модельной среды  $\varepsilon_L = 2$ ,  $\omega_p - 10^{16}$  толщины 2 и 10 nm для разных отношений  $\omega_c/\omega_p$ . ДУ нечетного *E*-ПП имеет вид  $n = \sqrt{\varepsilon^2 + |\varepsilon| \tanh^2 \theta} / \sqrt{\varepsilon^2 - \tanh^2 \theta}$ . В области  $\omega < \omega_s$  значительное замедление имеет место только при достаточно большой толщине, и в пределе  $t \to \infty$  оно также

вырождается в уравнение Ценнека. Для нечетного *E*-ПП возможна ветвь с аномальной отрицательной дисперсией, при этом на одной ее части плазмон может быть прямым, а на другой — обратным (рис. 3). В тонкой пленке также может существовать симметричный медленный *H*-ПП [5] с ДУ  $n = k_x/k_0 = \sqrt{1 + |\varepsilon|} \tanh^2 \theta / \sqrt{1 - \tanh^2 \theta}$ . Он обратный и сильно замедленный на низких частотах, имеет там большие потери, не имеет компоненты  $E_x$ , т.е. не взаимодействует с электронными потоками, поэтому его весьма трудно возбудить. С ростом *t* замедление и потери растут, но при  $t \to \infty$  он не существует. Результаты для прямых и обратных плазмонов приведены на рис. 3 для среды с  $\varepsilon_1 = 9 - 0.01i$  и  $\omega_p = 10^{16}$ ,  $\omega_c = 10^{13}$  Hz. Ветви обратных плазмонов, контролируемые по условию  $k_x'' < 0$ , обозначены символом *B*.

В работе в рамках модели Друде—Лоренца исследованы решения ДУ четного и нечетного электрических ПП и четного магнитного плазмона в металлических пленках. Получены аналитические оценки для максимального замедления и частоты плазмонного резонанса  $\tilde{\omega}_s < \omega_s$ . Для четного *E*-ПП аномальная дисперсия при диссипации имеет место, но обратного плазмона нет. Для нечетного *E*-ПП максимумы замедления определяются условием  $\varepsilon \approx \mp \tanh \theta$  и имеют место в плазмонной  $\omega < \omega_s$  и поляритонной  $\omega > \omega_p$  областях. Симметричный *H*-ПП существует в тонких пленках. Он обратный и замедленный в области низких частот при  $\tanh \theta \approx 1$ , где имеет существенные потери.

Потери приводят к возможности распространения плазмон-поляритонов в запрещенных зонах, при этом аномальная отрицательная дисперсия не означает наличие обратных плазмонов [5] (рис. 3). Возможны случаи обратных плазмонов при нормальной дисперсии, а также прямых плазмонов при аномальной дисперсии (рис. 1–3).

## Список литературы

- [1] Tournoisa P., Laude V. // Opt. Communications. 1997. V. 137. P. 41-45.
- [2] Liu Y.M., Pile D.F.P., Liu Z.W., Wu D.M., Sun C., Zhang X. // SPIE Opt. Photon. conf. San Diego, California, USA (Aug. 19–24, 2006). Proc. SPIE. 2006. V. 6323. P. 63231 M.

- [3] Федянин Д.Ю., Арсенин А.В., Лейман В.Г., Гладун А.Д. // Квантовая электроника. 2009. Т. 39. № 8. С. 745.
- [4] Зуев В.С., Зуева Г.Я. // Оптика и спектроскопия. 2008. Т. 105. С. 852–859.
- [5] Давидович М.В. Втекающие и вытекающие несобственные моды: анализ диссипативных дисперсионных уравнений и волна Ценнека. Саратов: Издво Саратов. ун-та, 2014. 104 с.